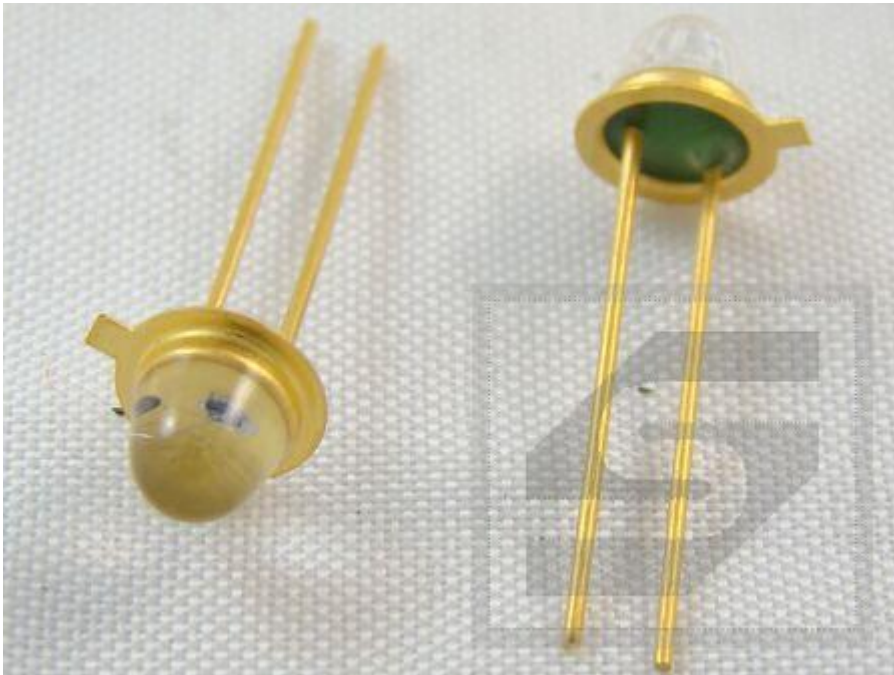




Dioda nadawcza CQYP16 CEMI



Dane techniczne:

Nazwa: CQYP16

Prąd diody: 40mA

Napięcie diody: 3V

Temperatura przechowywania: -40+70°C

Długość fali: 900-960nm

Zastosowanie: układy automatyki i kontroli, technika pomiarowa

Diody elektroluminescencyjne (promieniowanie podczerwone)

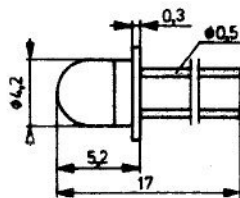
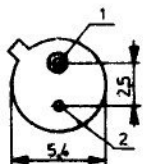
$t_{amb} = -40 \dots +55^{\circ}\text{C}$

Oznaczenie wyrobu	Parametry dopuszczalne			Parametry charakterystyczne							Zastosowa- nie	Obudo- wa
	I_F	U_R	t_{stg}	I_R przy		U_F	$P_e / I_e /$	λ	$\Delta \lambda$ przy			
	mA	V	$^{\circ}\text{C}$	μA	V	V	mW /mW/sr/	nm	nm	mA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CQWP 13	≤ 10	≤ 3	-40 ... +70	≤ 10	3	$\leq 1,5$	$\geq 0,2$	920 ... 960	≤ 100	10	układy automatyki i kontroli, technika pomiarowa	CO 30
CQWP 42 ^{x/}	≤ 100	≤ 5	-40 ... +70	≤ 100	5	$\leq 1,7$	/ ≥ 20 /	920 ... 960	≤ 100	100		CO 26
CQYP 15	≤ 100	≤ 3	-40 ... +80	≤ 10	3	$\leq 1,5$	$\geq 0,5$	900 ... 950	≤ 30	100		CO 09
COYP 16	≤ 40	≤ 3	-40 ... +70	≤ 10	3	$\leq 1,5$	$\geq 1,5$	900 ... 960	≤ 100	40		CO 09
CQYP 17	≤ 300	≤ 3	-40 ... +70	≤ 10	3	$\leq 1,7$	$\geq 0,5$	900 ... 950	≤ 30	300		CO 11
CQYP 19 ^{1/}	≤ 200	≤ 3	-40 ... +70	≤ 100	3	$\leq 1,5$	$\geq 1,0$	900 ... 950	≤ 30	200		CO 06
CQYP 20 ^{1/}	≤ 50	≤ 3	-40 ... +85	≤ 10	3	$\leq 1,7$	$\geq 2,5$	900 ... 960	≤ 100	50		CO 06
CQYP 23	≤ 100	≤ 5	-40 ... +85	≤ 100	5	$\leq 1,7$	A: / ≥ 10 / B: / ≥ 14 /	920 ... 960	≤ 100	100		CO 24
CQYP 57 ^{2/}	≤ 50	≤ 3	-40 ... +85	≤ 10	3	$\leq 1,5$	$\geq 0,1$	900 ... 940	≤ 30	50		CO 39

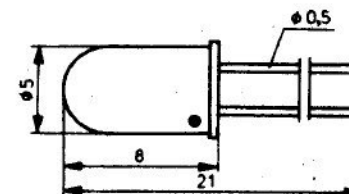
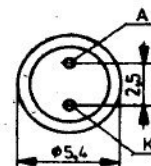
1/ wycofane z produkcji w 1982 r.

2/ oświetlacz składający się z dziewięciu diod w jednej obudowie, przeznaczony do czytników taśm perforowanych /wycofany z produkcji w w 1981 r./

x nowe uruchomienia



	1	2
BPXP28	E	C
CQYP15	K	A
CQYP16	K	A



CO 09

CO 24

CQYP23

Wykaz oznaczeń parametrów technicznych

E	natężenie oświetlenia	$U_{CE\ sat}$	napięcie nasycenia kolektor-emiter
E_e	natężenie promieniowania	U_{EC}	napięcie emiter-kolektor
f_T	częstotliwość graniczna	U_F	napięcie przewodzenia
I_e	gęstość promieniowania	U_n	napięcie szumów fotorezystora
I_F	prąd przewodzenia	U_R	napięcie wsteczne
I_{FI}	prąd wejściowy transoptora	U_{RI}	napięcie wejściowe transoptora
I_L	prąd jasny	U_{RO}	napięcie wsteczne na wyjściu transoptora
I_O	prąd ciemny	$\Delta\lambda$	szerokość charakterystyki widmowej
I_P	fotoprąd	λ	długość fali promieniowanej
I_R	prąd wsteczny	λ_{opt}	długość fali odpowiadająca maksimum charakterystyki widmowej
I_V	światłość	$/\lambda_1, \lambda_2/$	widmowy zakres pracy
I_{VS}	światłość segmentu		
K	stałoprądowy współczynnik wzmożenia prądowego		
NEP	moc równoważna szumowi		
P_e	moc promieniowania		
P_{tot}	moc całkowita		
R_L	rezystancja jasna fotorezystora		
R_O	rezystancja ciemna fotorezystora		
S	czułość fotorezystora		
$S_{I\lambda}$	czułość prądowa na promieniowanie monochromatyczne		
$S_{I\varphi}$	czułość prądowa na światło białe		
T	temperatura		
t_{amb}	temperatura otoczenia w czasie pracy		
T_b	temperatura barwowa źródła światła		
t_f	czas opadania		
t_r	czas narastania		
t_{ro}	czas narastania impulsu wyjściowego transoptora		
t_{stg}	temperatura przechowywania		
U	napięcie pracy fotorezystora		
$U_{BR/IO}$	napięcie przebicia wejście-wyjście transoptora		
U_{CE}	napięcie kolektor-emiter		